

SN74AHC126-Q1 車載用クワッド・バス・バッファ・ゲート、3 ステート出力搭載

1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み :
 - デバイス温度グレード 1 : -40°C ~ +125°C
 - デバイス HBM ESD 分類レベル 2
 - デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- ウェットタブル・フランク QFN (WBQA) パッケージで供給
- 動作範囲 : 2V ~ 5.5V V_{CC}
- 短い遅延、4.3 ns typical (25°C, 5 V)
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能

2 アプリケーション

- ドライブ・インジケータ LED
- 伝送ラインのロジックによる駆動
- デジタル信号のイネーブルまたはディセーブル

3 概要

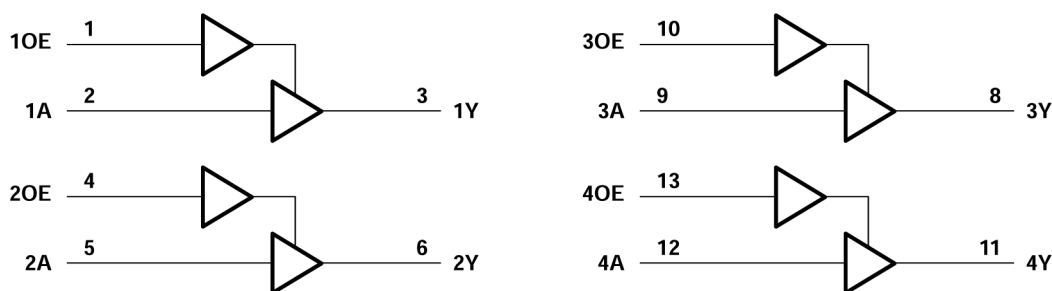
SN74AHC126-Q1 デバイスはクワッド・バス・バッファ・ゲートで、3 ステート出力の独立したライン・ドライバを備えています。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE を GND に接続できます。この抵抗の最小値は、電流ソース駆動能力によって決まります。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ・サイズ (2)	本体サイズ (公称) (3)
SN74AHC126-Q1	BQA (WQFN, 14)	3mm × 2.5mm	3mm × 2.5mm
	PW (TSSOP, 14)	5mm × 6.4mm	5mm × 4.4mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージ・サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



論理図 (正論理)



目次

1 特長.....	1	8 詳細説明.....	11
2 アプリケーション.....	1	8.1 概要.....	11
3 概要.....	1	8.2 機能ブロック図.....	11
4 改訂履歴.....	2	8.3 機能説明.....	11
5 ピン構成と機能.....	3	8.4 デバイスの機能モード.....	12
6 仕様.....	4	9 アプリケーションと実装.....	14
6.1 絶対最大定格.....	4	9.1 アプリケーション情報.....	14
6.2 ESD 定格.....	4	9.2 代表的なアプリケーション.....	14
6.3 推奨動作条件.....	5	9.3 電源に関する推奨事項.....	16
6.4 熱に関する情報.....	5	9.4 レイアウト.....	16
6.5 電気的特性.....	6	10 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	17
6.6 スイッチング特性、 $V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$	6	10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	17
6.7 スイッチング特性、 $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$	7	10.2 サポート・リソース.....	17
6.8 ノイズ特性.....	7	10.3 商標.....	17
6.9 動作特性.....	7	10.4 静電気放電に関する注意事項.....	17
6.10 標準的特性.....	8	10.5 用語集.....	17
7 パラメータ測定情報.....	10	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	17

4 改訂履歴

日付	改訂	注
2023 年 8 月	*	初版

5 ピン構成と機能

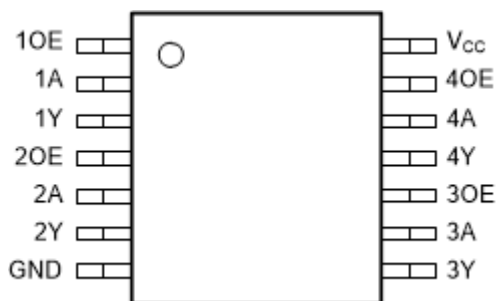


図 5-1. PW パッケージ、14 ピン (上面図)

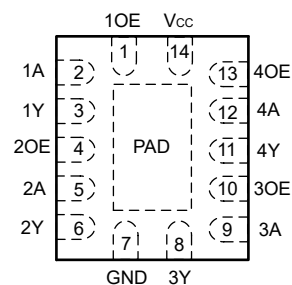


図 5-2. BQA パッケージ、WQFN 14 ピン (透過上面図)

表 5-1. ピンの機能

ピン		種類 ⁽¹⁾	説明
名称	番号		
10E	1	I	チャンネル 1、出力イネーブル
1A	2	I	チャンネル 1、A 入力
1Y	3	O	チャンネル 1、Y 出力
2OE	4	I	チャンネル 2、出力イネーブル
2A	5	I	チャンネル 2、A 入力
2Y	6	O	チャンネル 2、Y 出力
GND	7	G	グランド
3Y	8	O	チャンネル 3、Y 出力
3A	9	I	チャンネル 3、A 入力
3OE	10	I	チャンネル 3、OE 入力
4Y	11	O	チャンネル 4、Y 出力
4A	12	I	チャンネル 4、A 入力
4OE	13	I	チャンネル 4、OE 入力
V _{CC}	14	P	正電源
サーマル・パッド ⁽²⁾		—	サーマル・パッド：GND に接続するか、フローティングのままにします

(1) I = 入力、O = 出力、P = 電源、G = グランド

(2) BQA パッケージに限定

6 仕様

6.1 絶対最大定格

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧範囲	-0.5	7	V
V_I ⁽²⁾	入力電圧範囲	-0.5	7	V
V_O ⁽²⁾	出力電圧範囲	-0.5	$V_{CC} + 0.5$	V
I_{IK}	入力クランプ電流	$(V_I < 0)$		-20 mA
I_{OK}	出力クランプ電流	$(V_O < 0 \text{ または } V_O > V_{CC})$		± 20 mA
I_O	連続出力電流	$(V_O = 0 \sim V_{CC})$		± 25 mA
	V_{CC} または GND を通過する連続電流			± 50 mA
T_J	接合部温度			150 °C
T_{stg}	保管温度範囲	-65	150	°C

- (1) 「絶対最大定格」の範囲を超える動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

6.2 ESD 定格

			値	単位
$V_{(ESD)}$	静電放電	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 HBM ESD 分類レベル 2 準拠 ⁽¹⁾	± 2000	V
		デバイス帯電モデル (CDM)、AEC Q100-011 CDM ESD 分類レベル C4B 準拠	± 1000	

- (1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 仕様に従って実施しなければならないと規定しています。

6.3 推奨動作条件

			最小値	最大値	単位
V_{CC}	電源電圧		2	5.5	V
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 2V$	1.5		V
		$V_{CC} = 3V$	2.1		
		$V_{CC} = 5.5V$	3.85		
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 2V$		0.5	V
		$V_{CC} = 3V$		0.9	
		$V_{CC} = 5.5V$		1.65	
$V_I^{(1)}$	入力電圧		0	5.5	V
V_O	出力電圧		0	V_{CC}	V
$I_{OH}^{(2)}$	High レベル出力電流	$V_{CC} = 2V$		-50	μA
		$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$		-4	mA
		$V_{CC} = 5V \pm 0.5V$		-8	
$I_{OL}^{(2)}$	Low レベル出力電流	$V_{CC} = 2V$		50	μA
		$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$		4	mA
		$V_{CC} = 5V \pm 0.5V$		8	
$\Delta t/\Delta v$	入力遷移の立ち上がりレートまたは立ち下がりレート	$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$		100	ns/V
		$V_{CC} = 5V \pm 0.5V$		20	
T_A	自由空気での動作温度		-40	125	$^{\circ}C$

- (1) デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、 V_{CC} または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーション・レポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』(文献番号 SCBA004) を参照してください。
- (2) 関連する出力電圧仕様に従って適切な出力状態を維持するための推奨電流値 (I_{OL} は V_{OL} 、 I_{OH} は V_{OH} に対応)。詳細については、「電気的特性」表を参照してください。

6.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		WBQA	PW	単位
		14 ピン		
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	88.3	151.0	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	90.9	80.0	
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	56.8	94.2	
ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	9.9	28.0	
ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	56.7	93.6	
R _{θJC(bot)}	接合部からケース (底面) への熱抵抗	33.4	該当なし	

- (1) 従来および新しい熱評価基準の詳細については、『IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション・レポート、[SPRA953](#) を参照してください。

6.5 電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件	V _{CC}	T _A = 25°C			-40 ~ +125°C		単位
			最小値	代表値	最大値	最小値	最大値	
V _{OH}	I _{OH} = -50μA	2V	1.9	2		1.9		V
		3V	2.9	3		2.9		
		4.5V	4.4	4.5		4.4		
	I _{OH} = -4mA	3V	2.58			2.48		
	I _{OH} = -8mA	4.5V	3.94			3.8		
V _{OL}	I _{OL} = 50μA	2V			0.1		0.1	V
		3V			0.1		0.1	
		4.5V			0.1		0.1	
	I _{OL} = 4mA	3V			0.36		0.44	
	I _{OL} = 8mA	4.5V			0.36		0.44	
I _I	V _I = 5.5V または GND	0V ~ 5.5V			±0.1		±1	μA
I _{OZ}	V _I = V _{CC} または GND	5.5V			±0.25		±2.5	μA
I _{CC}	V _I = V _{CC} または GND、 I _O = 0	5.5V			4		40	μA
C _i	V _I = V _{CC} または GND	5V		4	10		10	pF

6.6 スイッチング特性、V_{CC} = 3.3V ± 0.3V

自由気流での推奨動作温度範囲内、V_{CC} = 3.3 V ± 0.3 V (特に記述のない限り) (セクション 7 を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	T _A = 25°C			-40 ~ +125°C		単位
				最小値	代表値	最大値	最小値	最大値	
t _{PLH}	A	Y	C _L = 15pF	5.6		8	1	9.5	ns
t _{PHL}				5.6		8	1	9.5	
t _{PZH}	OE	Y	C _L = 15pF	5.4		8	1	9.5	ns
t _{PZL}				5.4		8	1	9.5	
t _{PHZ}	OE	Y	C _L = 15pF	7		9.7	1	11.5	ns
t _{PLZ}				7		9.7	1	11.5	
t _{PLH}	A	Y	C _L = 50pF	8.1		11.5	1	13	ns
t _{PHL}				8.1		11.5	1	13	
t _{PZH}	OE	Y	C _L = 50pF	7.9		11.5	1	13	ns
t _{PZL}				7.9		11.5	1	13	
t _{PHZ}	OE	Y	C _L = 50pF	9.5		13.2	1	15	ns
t _{PLZ}				9.5		13.2	1	15	
t _{sk(o)}			C _L = 50pF			1.5		1.5	ns

6.7 スイッチング特性、 $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$

自由気流での推奨動作温度範囲内、 $V_{CC} = 5V \pm 0.5V$ (特に記述のない限り) (セクション 7 を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	負荷容量	$T_A = 25^\circ\text{C}$			$-40 \sim +125^\circ\text{C}$		単位
				最小値	代表値	最大値	最小値	最大値	
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 15\text{pF}$		3.8	5.5	1	6.5	ns
t_{PHL}					3.8	5.5	1	6.5	
t_{PZH}	OE	Y	$C_L = 15\text{pF}$		3.6	5.1	1	6	ns
t_{PZL}					3.6	5.1	1	6	
t_{PHZ}	OE	Y	$C_L = 15\text{pF}$		4.6	6.8	1	8	ns
t_{PLZ}					4.6	6.8	1	8	
t_{PLH}	A	Y	$C_L = 50\text{pF}$		5.3	7.5	1	8.5	ns
t_{PHL}					5.3	7.5	1	8.5	
t_{PZH}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$		5.1	7.1	1	8	ns
t_{PZL}					5.1	7.1	1	8	
t_{PHZ}	OE	Y	$C_L = 50\text{pF}$		6.1	8.8	1	10	ns
t_{PLZ}					6.1	8.8	1	10	
$t_{sk(o)}$			$C_L = 50\text{pF}$			1		1	ns

6.8 ノイズ特性

$V_{CC} = 5V$, $C_L = 50\text{pF}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$ ⁽¹⁾

パラメータ		最小値	代表値	最大値	単位
$V_{OL(P)}$	低ノイズ出力、最大動的 V_{OL}		0.2	0.8	V
$V_{OL(V)}$	低ノイズ出力、最小動的 V_{OL}	-0.9	-0.2		V
$V_{OH(V)}$	低ノイズ出力、最小動的 V_{OH}	4.4	4.7		V
$V_{IH(D)}$	High レベル動的入力電圧	3.5			V
$V_{IL(D)}$	Low レベル動的入力電圧			1.5	V

(1) 特性は表面実装パッケージに限定です。

6.9 動作特性

$V_{CC} = 5V$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

パラメータ		テスト条件		代表値	単位
C_{pd}	消費電力キャパシタンス	無負荷、	$f = 1\text{MHz}$	14	pF

6.10 標準的特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

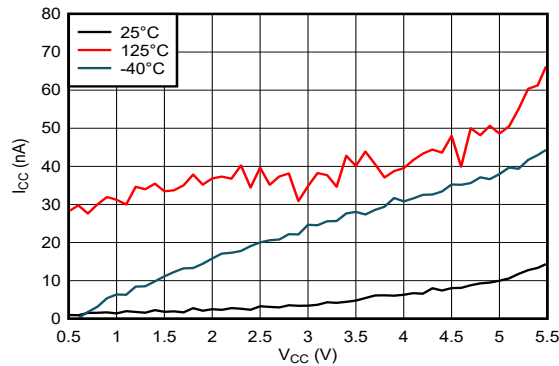


図 6-1. 電源電流と電源電圧との関係

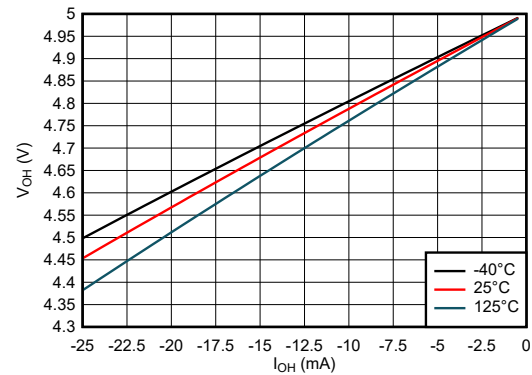


図 6-2. 出力電圧と High 状態の電流との関係 (5V 電源)

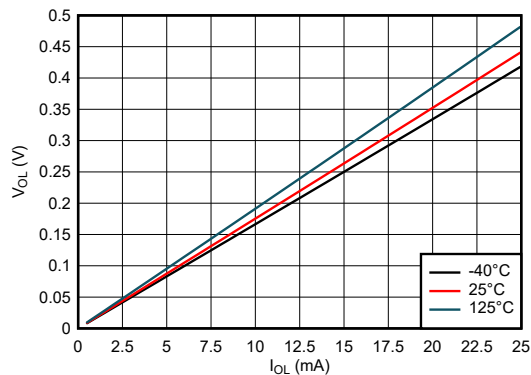


図 6-3. Low 状態における出力電圧と電流の関係、5V 電源

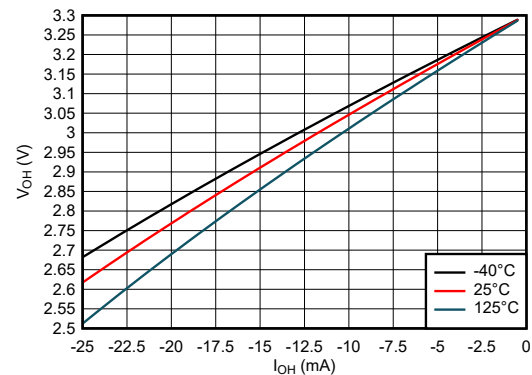


図 6-4. 出力電圧と High 状態の電流との関係 (3.3V 電源)

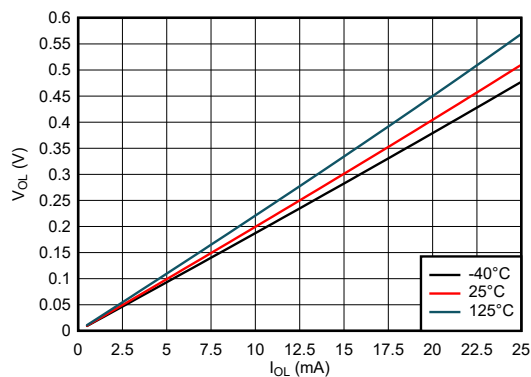


図 6-5. 出力電圧と Low 状態の電流との関係 (3.3V 電源)

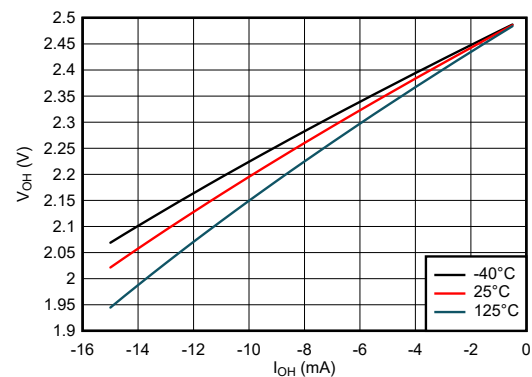


図 6-6. 出力電圧と High 状態の電流との関係 (2.5V 電源)

6.10 標準的特性 (continued)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ (特に記述のない限り)

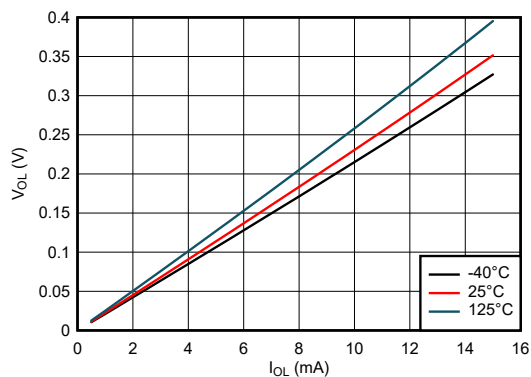


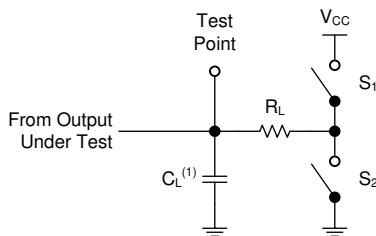
図 6-7. 出力電圧と Low 状態の電流との関係 (2.5V 電源)

7 パラメータ測定情報

以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータから供給されます：PRR ≤ 1MHz、 $Z_O = 50\Omega$ 、 $t_f < 3\text{ ns}$ 。

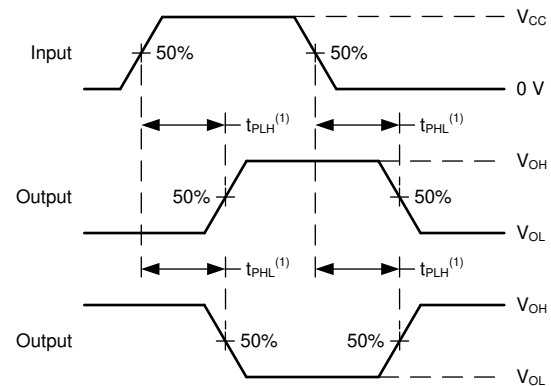
出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。

テスト	S1	S2	R_L	C_L	ΔV	V_{CC}
t_{PLH} 、 t_{PHL}	オープン	オープン	—	15pF、50pF	—	すべて
t_{PLZ} 、 t_{PZL}	クローズ	オープン	1k Ω	15pF、50pF	0.15V	≤ 2.5V
t_{PHZ} 、 t_{PZH}	オープン	クローズ	1k Ω	15pF、50pF	0.15V	≤ 2.5V
t_{PLZ} 、 t_{PZL}	クローズ	オープン	1k Ω	15pF、50pF	0.3V	> 2.5 V
t_{PHZ} 、 t_{PZH}	オープン	クローズ	1k Ω	15pF、50pF	0.3V	> 2.5 V



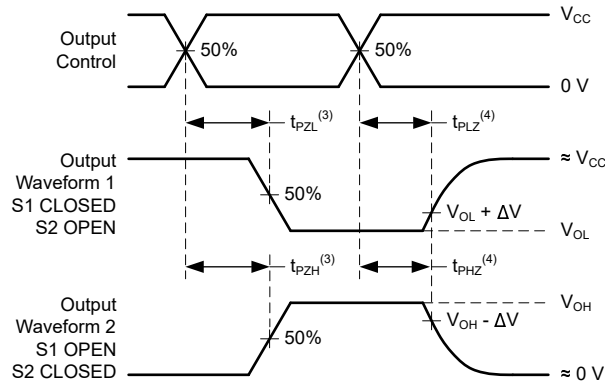
(1) C_L にはプローブとテスト装置の容量が含まれます。

図 7-1.3 ステート出力用負荷回路



(1) t_{PLH} と t_{PHL} の大きいほうは、 t_{pd} と等しくなります。

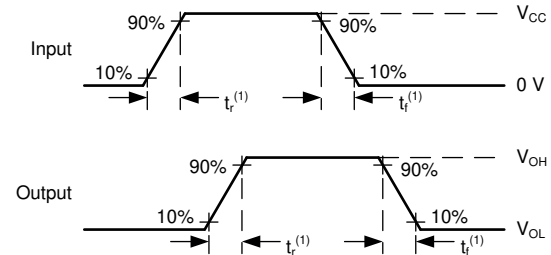
図 7-2. 電圧波形の伝搬遅延



(3) t_{PZL} と t_{PZH} の大きいほうは、 t_{en} と等しくなります。

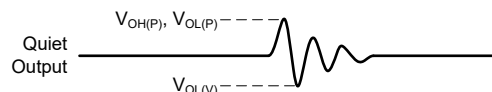
(4) t_{PLZ} と t_{PHZ} の大きいほうは、 t_{dis} と等しくなります。

図 7-3. 電圧波形の伝搬遅延



(1) t_r と t_f の大きいほうは、 t_t と等しくなります。

図 7-4. 電圧波形、入力および出力の遷移時間



他のすべての出力を同時にスイッチングして測定されたノイズ値。

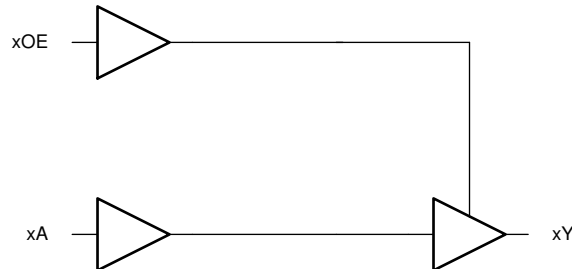
図 7-5. 電圧波形、ノイズ

8 詳細説明

8.1 概要

このデバイスは、3 ステート出力を備えた 4 個の独立なバッファを搭載しています。各ゲートはブール関数 $Y = A$ を正論理で実行します。

8.2 機能ブロック図



4 つのチャンネルのいずれかひとつ

8.3 機能説明

8.3.1 平衡な CMOS 3 ステート出力

このデバイスには、平衡な CMOS 3 ステート出力が内蔵されています。High、Low、高インピーダンスの 3 つの状態は、これらの出力に対応できます。平衡化という用語は、このデバイスが同様の電流をシンクおよびソースできることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成されるため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

高インピーダンス・モードに移行したとき、出力は電流のソースとシンクのどちらも行いません。ただし、「電気的特性」表に定義されている小さなリーク電流は例外です。高インピーダンス状態では、出力電圧はデバイスによって制御されず、外部要因に依存します。ノードに他のドライバが接続されていない場合、これはフローティング・ノードと呼ばれ、電圧は不明です。出力にプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を接続することで、高インピーダンス状態の出力に既知の電圧を供給できます。抵抗の値は、寄生容量や消費電力の制限など複数の要因に依存します。通常、これらの要件を満たすために 10kΩ の抵抗を使用できます。

未使用の 3 ステート CMOS 出力は、未接続のままにする必要があります。

8.3.2 標準 CMOS 入力

このデバイスには、標準 CMOS 入力 that 搭載されています。標準 CMOS 入力は高インピーダンスであり、通常は「電気的特性」に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。最悪条件下の抵抗は「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ($R = V \div I$) を使用して計算します。

標準 CMOS 入力では、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されるように、有効なロジック状態間で入力信号を迅速に遷移させる必要があります。この仕様を満たさないと、消費電力が過剰になり、発振の原因となる可能性があります。詳細については、『[低速またはフローティング CMOS 入力の影響](#)』を参照してください。

動作中は、標準 CMOS 入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は、 V_{CC} または GND に終端する必要があります。システムが常に入力をアクティブに駆動しない場合は、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加して、これらの期間中に有効な入力電圧を供給できます。抵抗値は複数の要因に依存しますが、10kΩ の抵抗を推奨します。通常はこれですべての要件を満たします。

8.3.3 ウェッタブル・フランク

このデバイスには、少なくとも 1 つのパッケージのウェッタブル・フランクが含まれています。この機能を搭載しているパッケージについては、データシートの先頭ページにある「特長」セクションを参照してください。

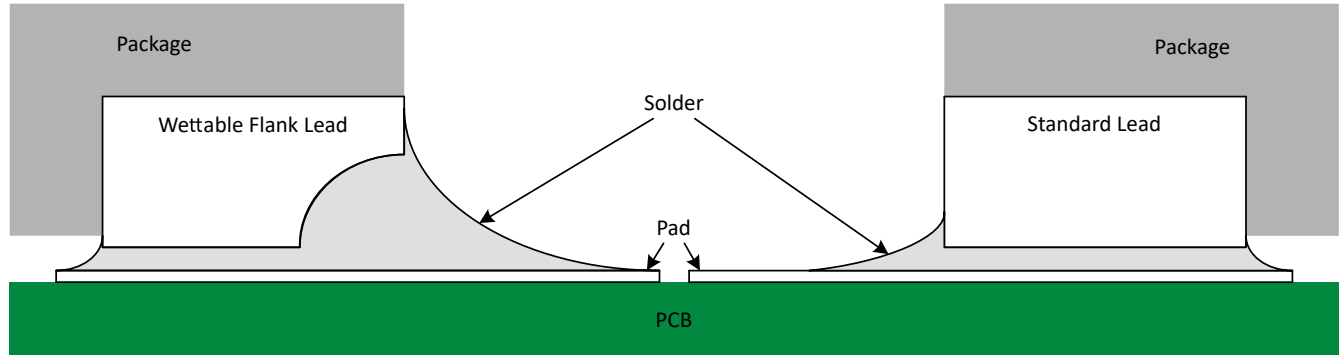


図 8-1. 半田付け後のウェッタブル・フランク QFN パッケージと標準 QFN パッケージの概略断面図

ウェッタブル・フランクは、半田付け後の側方のぬれ性を改善するのに役立ち、自動光学検査 (AOI) により QFN パッケージの検査が容易になります。ウェッタブル・フランクは、図 8-1 に示すように、半田接着用の表面積を追加するために、デインプル加工または段切りできます。これは、サイド・フィレットを確実に作成するのに役立ちます。詳細については、メカニカルに関する図をご覧ください。

8.3.4 クランプ・ダイオード構造

図 8-2 に示すように、このデバイスへの出力には正と負の両方のクランプ・ダイオードがあり、このデバイスへの入力には負のクランプ・ダイオードのみがあります。

注意

「絶対最大定格」表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧の定格を超えることがあります。

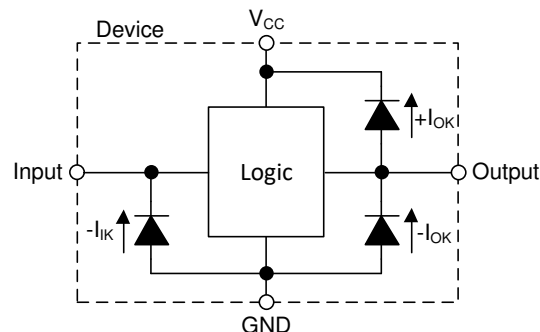


図 8-2. 各入力と出力に対するクランプ・ダイオードの電氣的配置

8.4 デバイスの機能モード

表 8-1. 機能表

入力		出力
OE	A	Y
L	X	Z
H	L	L

表 8-1. 機能表 (continued)

入力		出力
OE	A	Y
H	H	H

9 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

9.1 アプリケーション情報

SN74AHC126-Q1 は、比較的長いパターンや伝送ラインで信号を駆動するために使用できます。ドライバ、伝送ライン、レシーバの間のインピーダンスの不整合に起因するリンギングを低減するために、トランスミッタの出力と直列に配置した直列ダンピング抵抗を使用できます。「アプリケーション曲線」セクションの図は、3つの個別の抵抗値を持つ受信信号を示しています。この種のアプリケーションでは、わずかな抵抗だけで信号の整合性に大きな影響を及ぼす可能性があります。

9.2 代表的なアプリケーション

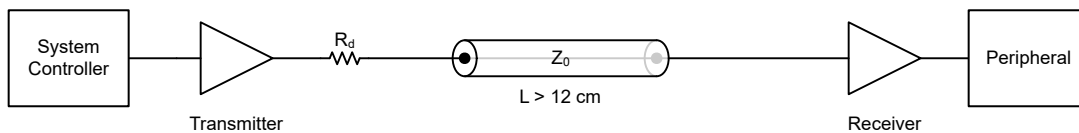


図 9-1. 代表的なアプリケーションのブロック図

9.2.1 設計要件

9.2.1.1 電源に関する考慮事項

目的の電源電圧が「推奨動作条件」で規定されている範囲内であることを確認します。「電気的特性」セクションに記載されているように、電源電圧はデバイスの電気的特性を設定します。

正の電源電圧は、「電気的特性」に示されている最大静的電源電流 I_{CC} に SN74AHC126-Q1 のすべての出力がソースとする合計電流を加えた電流と、スイッチングに必要な過渡電流をソースできる必要があります。ロジック・デバイスは、正の電源から供給される電流量のみをソースできます。「絶対最大定格」に記載されている V_{CC} を流れる最大合計電流を超えないようにしてください。

グランドは、SN74AHC126-Q1 のすべての出力によってシンクされる合計電流に「電気的特性」に記載されている最大電源電流 I_{CC} を加えた電流と、スイッチングに必要な過渡電流をシンクできる必要があります。ロジック・デバイスは、グランド接続にシンクできる電流量のみをシンクできます。「絶対最大定格」に記載されている GND を流れる最大合計電流を超えないようにしてください。

SN74AHC126-Q1 は、データシートのすべての仕様を満たしながら、合計容量が 50pF 以下の負荷を駆動できます。より大きな容量性負荷を印加することもできますが、50pF を超えないようにすることを推奨します。

SN74AHC126-Q1 は、「電気的特性」表に定義されている出力電圧および電流 (V_{OH} および V_{OL}) で、 $R_L \geq V_O / I_O$ で記述される合計抵抗の負荷を駆動できます。HIGH 状態で出力する場合、式の出力電圧は、測定された出力電圧と V_{CC} ピンの電源電圧との差として定義されます。

総消費電力は、『CMOS の消費電力と CPD の計算』に記載されている情報を使用して計算できます。

熱上昇は、『標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性』に記載されている情報を使用して計算できます。

注意

「絶対最大定格」に記載されている最大接合部温度 $T_{J(max)}$ は、デバイスの損傷を防止するための追加の制限です。「絶対最大定格」に記載されている値を超えないようにしてください。これらの制限値は、デバイスの損傷を防止するために規定されています。

9.2.1.2 入力に関する考慮事項

入力信号がロジック LOW と見なされるには $V_{IL(max)}$ を下回る必要があり、ロジック HIGH と見なされるには $V_{IH(min)}$ を上回る必要があります。「絶対最大定格」に記載されている最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。

未使用の入力は、 V_{CC} またはグランドに終端する必要があります。入力がまったく使用されていない場合は、未使用の入力を直接終端できます。入力が時々使用される場合、または常には使用されない場合は、プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を使用して接続できます。デフォルト状態が HIGH の場合はプルアップ抵抗を使用し、デフォルト状態が LOW の場合はプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SN74AHC126-Q1 へのリーク電流（「電気的特性」で規定）、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。これらの要因により、多くの場合は 10k Ω の抵抗値が使用されます。

SN74AHC126-Q1 には CMOS 入力があるため、正しく動作させるためには、「推奨動作条件」表に定義されているように、入力遷移が高速である必要があります。入力遷移が遅いと、発振が発生し、消費電力が増加して、デバイスの信頼性が低下する可能性があります。

このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

9.2.1.3 出力に関する考慮事項

出力 HIGH 電圧は、正の電源電圧を使用して生成します。「電気的特性」の V_{OH} 仕様に規定されているように、出力から電流を引き込むと出力電圧が低下します。出力 LOW 電圧は、グランド電圧を使用して生成します。「電気的特性」の V_{OL} 仕様に規定されているように、出力に電流をシンクすると出力電圧が上昇します。

非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力同士は、直接接続しないでください。これにより過電流が発生し、デバイスが損傷する可能性があります。

同じデバイス内で、同じ入力信号を持つ 2 つのチャネルを並列に接続すると、出力駆動能力を高めることができます。

未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を直接 V_{CC} またはグランドに接続しないでください。

このデバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。

9.2.2 詳細な設計手順

1. V_{CC} と GND の間にデカップリング・コンデンサを追加します。このコンデンサは物理的にデバイスの近く、かつ V_{CC} ピンと GND ピンの両方に電氣的に近づけて配置する必要があります。レイアウト例を「レイアウト」セクションに示します。
2. 出力の容量性負荷が 50pF 以下であることを確認します。これは厳密な制限ではありませんが、設計上、性能が最適化されます。これは、SN74AHC126-Q1 から 1 つまたは複数の受信デバイスまでの短い適切なサイズのトレースを提供することで実現できます。
3. 出力の抵抗性負荷が $(V_{CC} / I_{O(max)}) \Omega$ より大きいことを確認します。これを行うと、「絶対最大定格」の最大出力電流に違反するのを防ぐことができます。ほとんどの CMOS 入力には、M Ω で測定される抵抗性負荷があります。これは、前に計算した最小値よりもはるかに大きくなります。
4. 熱の問題がロジック・ゲートにとって問題となることはほとんどありません。ただし、消費電力と熱の上昇は、アプリケーション・レポート『[CMOS 消費電力と CPD の計算](#)』に記載されている手順を使用して計算できます。

9.2.3 アプリケーション曲線

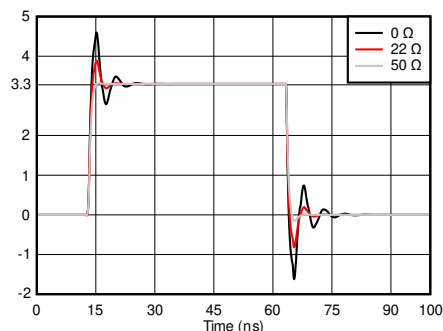


図 9-2. 異なるダンピング抵抗 (R_d) 値を使用してレシーバでの信号の整合性をシミュレート

9.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電力障害を防止するため、各 V_{CC} 端子に適切なバイパス・コンデンサを配置する必要があります。このデバイスには 0.1 μ F のコンデンサをお勧めします。複数のバイパス・コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが可能です。一般的に、0.1 μ F と 1 μ F のコンデンサは並列に使用されます。バイパス・コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

9.4 レイアウト

9.4.1 レイアウトのガイドライン

マルチ入力およびマルチチャネルの論理デバイスを使用する場合、入力をフローティングのままにしないでください。多くの場合、デジタル論理デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、トリプル入力 AND ゲートの 2 つの入力のみを使用する場合や 4 つのバッファ・ゲートのうちの 3 つのみを使用する場合)。このような未使用の入力ピンを未接続のままにしないでください。外部接続の電圧が未確定の場合、動作状態が不定になるためです。デジタル論理デバイスの未使用入力はすべて、フローティングにならないよう、入力電圧の仕様が定義されているように論理 High が論理 Low に接続する必要があります。特定の未使用の入力に対して適用が必要となる論理レベルは、デバイスの機能により異なります。一般に入力は、GND または V_{CC} のうち、論理機能にとってより適切であるかより利便性の高い方に接続されます。

9.4.2 レイアウト例

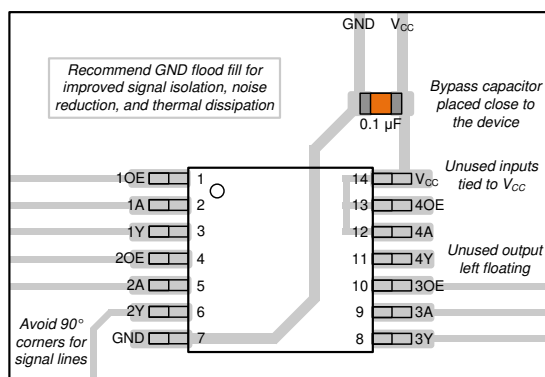


図 9-3. SN74AHC126-Q1 のレイアウト例

10 デバイスおよびドキュメントのサポート

10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.com のデバイス製品フォルダを開いてください。「更新の通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

10.2 サポート・リソース

TI E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の[使用条件](#)を参照してください。

10.3 商標

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

10.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

10.5 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集 この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに対して提供されている最新のデータです。このデータは予告なく変更され、本ドキュメントの改訂に従って修正される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用している場合は、画面左側のナビゲーションをご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
SN74AHC126QPWRQ1	ACTIVE	TSSOP	PW	14	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AC126Q	Samples
SN74AHC126QWBQARQ1	ACTIVE	WQFN	BQA	14	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AC126Q	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74AHC126-Q1 :

- Catalog : [SN74AHC126](#)
- Military : [SN54AHC126](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

GENERIC PACKAGE VIEW

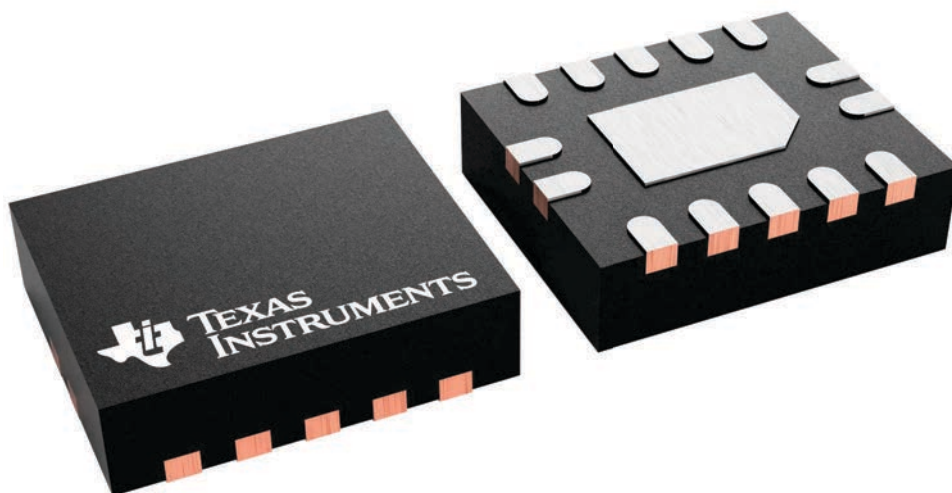
BQA 14

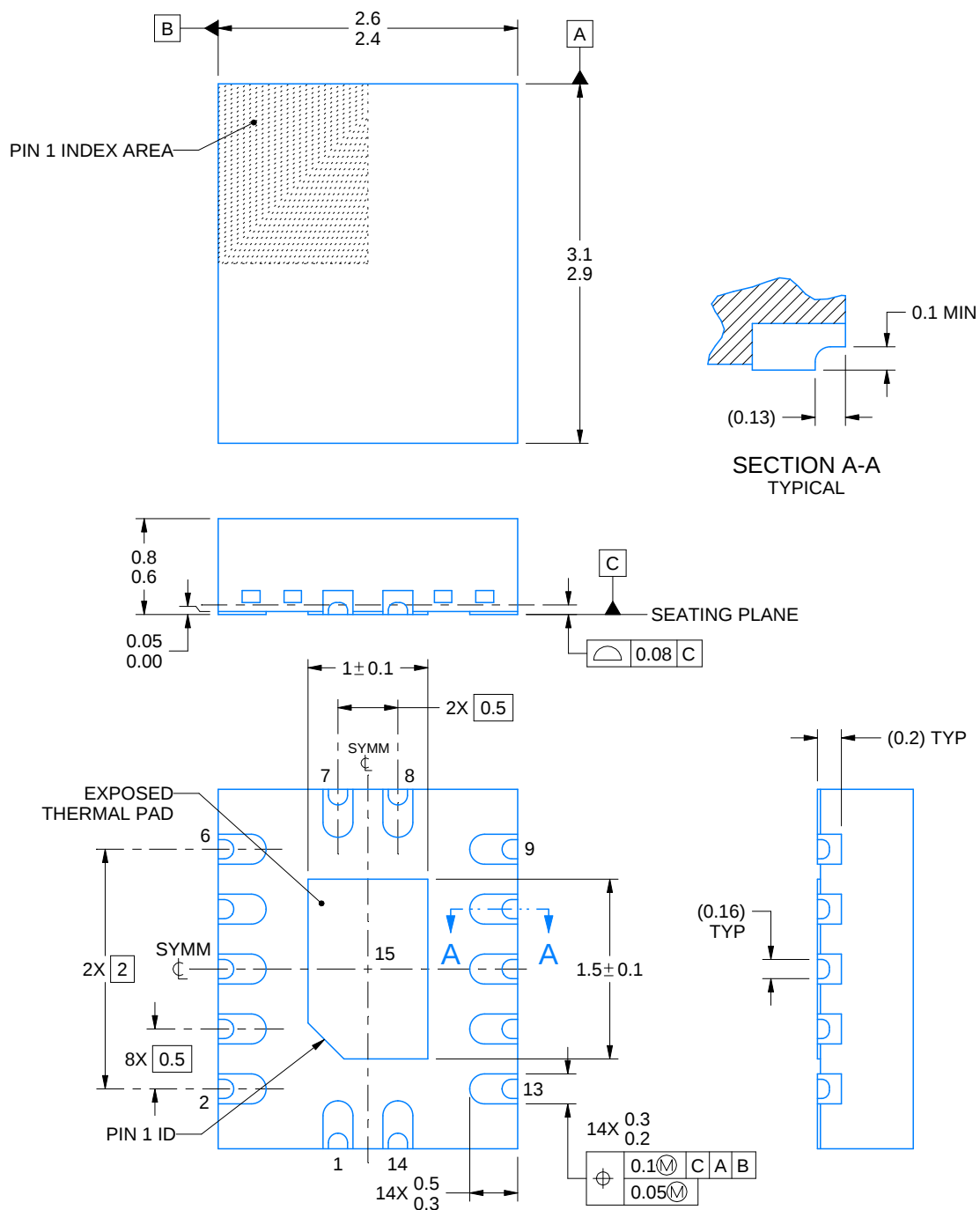
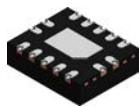
WQFN - 0.8 mm max height

2.5 x 3, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.





4227062/B 09/2021

NOTES:

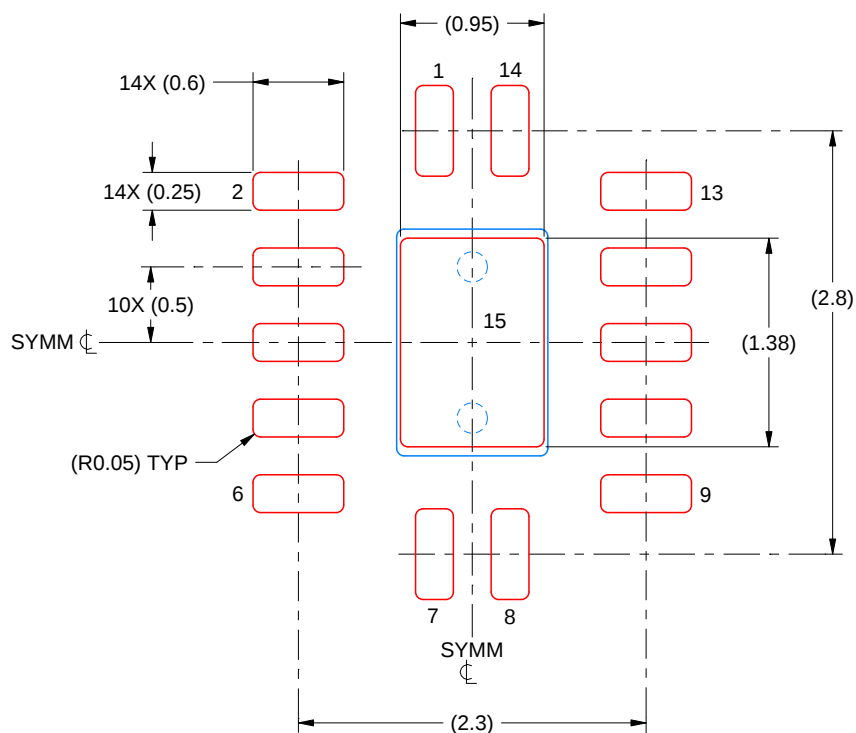
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

BQA0014B

WQFN - 0.8 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 20X

EXPOSED PAD 15
87% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

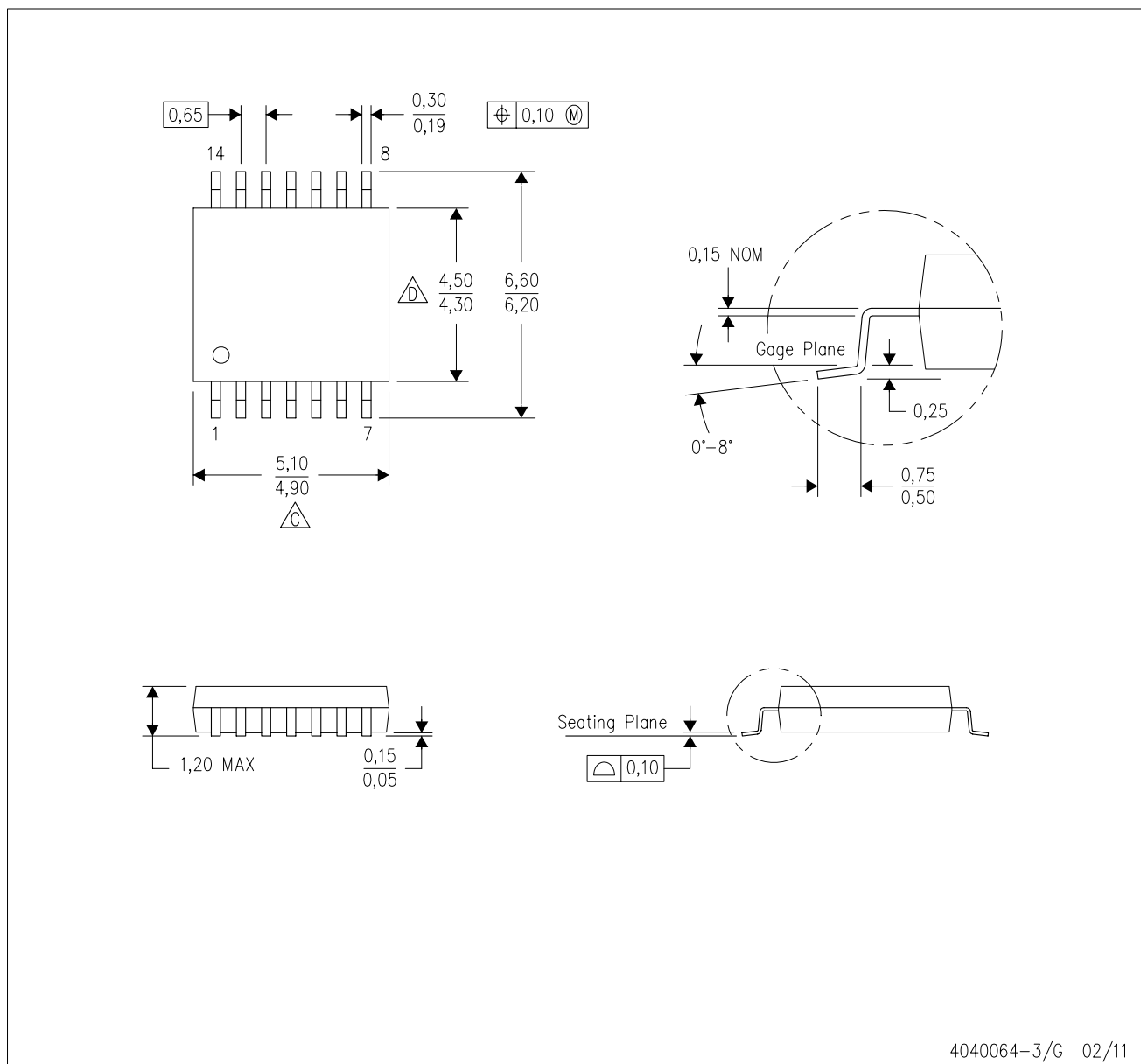
4227062/B 09/2021

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

PW (R-PDSO-G14)

PLASTIC SMALL OUTLINE



重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとしします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated